

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成25年9月26日(2013.9.26)

【公開番号】特開2013-140716(P2013-140716A)

【公開日】平成25年7月18日(2013.7.18)

【年通号数】公開・登録公報2013-038

【出願番号】特願2012-399(P2012-399)

【国際特許分類】

H 01 B 7/08 (2006.01)

【F I】

H 01 B 7/08

【手続補正書】

【提出日】平成25年7月31日(2013.7.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

絶縁フィルムと介在層を合わせた絶縁フィルムの実効比誘電率を、絶縁フィルムの比誘電率を 1、介在層の比誘電率を 2 とすると、は 1 と 2 との加重平均である。図2などの断面で絶縁フィルムの断面積を S1、介在層の断面積を S2 とすると、= (1 S1 + 2 S2) / (S1 + S2) である。

平角導体からシールド層までの非金属層の実効比誘電率は図5の場合では絶縁フィルム3と介在層7とを合わせた比誘電率となる。絶縁フィルム3の比誘電率を介在層7の比誘電率よりも小さくすることにより、両者を合わせた比誘電率(言い換えると平角導体からシールド層までの非金属層の実効比誘電率)は絶縁フィルム3の比誘電率よりも大きくなる。